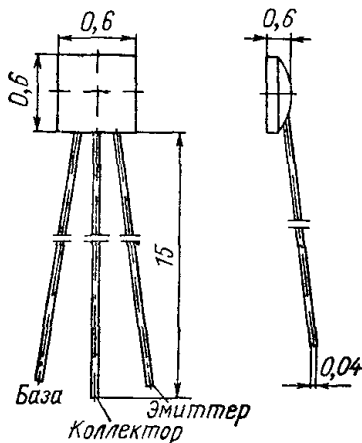


2Т324А-1, 2Т324Б-1, 2Т324В-1, 2Т324Г-1, 2Т324Д-1, 2Т324Е-1, КТ324А-1, КТ324Б-1, КТ324В-1, КТ324Г-1, КТ324Д-1, КТ324Е-1

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные *n-p-n* переключаемые маломощные и СВЧ усилительные с ненормированным коэффициентом шума



Предназначены для переключения (2Т324А-1, 2Т324Б-1, 2Т324В-1, 2Т324Г-1, КТ324А-1, КТ324Б-1, КТ324В-1, КТ324Г-1) и усиления сигналов высокой частоты (2Т324Д-1, 2Т324Е-1, КТ324Д-1, КТ324Е-1)

Бескорпусные, без кристаллодержателя, с гибкими выводами и защитным покрытием на основе кремнийорганического лака. Выпускаются в сопроводительной таре. Обозначение типа приводится на этикетке.

Масса транзистора не более 0,002 г

Электрические параметры

Граничная частота при $U_{КБ} = 2$ В, $I_Э = 5$ мА не менее

2Т324А-1, 2Т324Б-1, 2Т324В-1, КТ324А-1, КТ324Б-1, КТ324В-1	800 МГц
2Т324Г-1, 2Т324Д-1, 2Т324Е-1, КТ324Г-1, КТ324Д-1, КТ324Е-1	600 МГц

Постоянная времени цепи обратной связи при $U_{КБ} = 2$ В, $I_Э = 5$ мА, $f = 10$ МГц 2Т324Д-1, 2Т324Е-1, КТ324Д-1, КТ324Е-1 не более 180 пс

Время рассасывания при $I_К = 10$ мА, $I_{Б1} = 1$ мА, $I_{Б2} = 1,2$ мА, $R_К = 75$ Ом не более

2Т324А-1, 2Т324Б-1, 2Т324В-1, КТ324А-1, КТ324Б-1, КТ324В-1	10 нс
2Т324Г-1, КТ324Г-1	15 нс

Материал взят из источника:

Полупроводниковые приборы: Транзисторы. Горюнов Н. Н. (ред)
Энергоатомиздат, 1985

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $E_K = 0$, $I_K = 10$ мА

при $T = 298$ К

2Т324А-1, КТ324А-1	20–60
2Т324Б-1, 2Т324Г-1, КТ324Б-1, КТ324Г-1	40–120
2Т324В-1, КТ324В-1	80–250
2Т324Д-1, КТ324Д-1	20–80
2Т324Е-1, КТ324Е-1	60–250

при $T = 213$ К

2Т324А-1	8–60
2Т324Б-1, 2Т324Г-1	16–120
2Т324В-1	32–250
2Т324Д-1	8–80
2Т324Е-1	24–250

при $T = 358$ К

2Т324А-1	20–120
2Т324Б-1, 2Т324Г-1	40–240
2Т324В-1	80–500
2Т324Д-1	20–160
2Т324Е-1	60–500

Граничное напряжение при $I_Э = 1$ мА 2Т324А-1, 2Т324Б-1, 2Т324В-1, 2Т324Г-1, 2Т324Д-1, 2Т324Е-1 не менее 5 В

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_K = 10$ мА, $I_Б = 1$ мА не более 0,3 В

Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_K = 10$ мА, $I_Б = 1$ мА не более 1,1 В

Обратный ток коллектора при $U_{КБ} = 10$ В не более: при $T = 298$ К 0,5 мкА

при $T = 358$ К 2Т324А-1, 2Т324Б-1, 2Т324В-1, 2Т324Г-1, 2Т324Д-1, 2Т324Е-1 10 мкА

Обратный ток эмиттера при $T = 298$ К, $U_{КБ} = 4$ В не более 1 мкА

Емкость коллекторного перехода при $U_{КБ} = 5$ В не более 2,5 пФ

Емкость эмиттерного перехода при $U_{ЭБ} = 0$ В не более 2,5 пФ

Материал взят из источника:

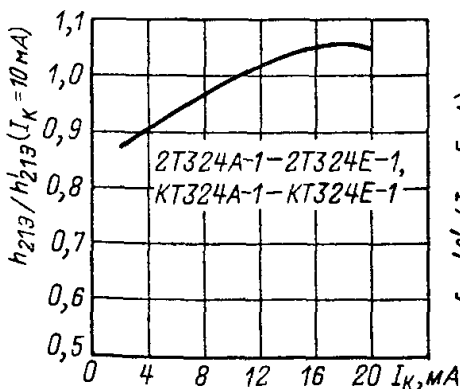
Полупроводниковые приборы: Транзисторы. Горюнов Н. Н. (ред)

Энергоатомиздат, 1985

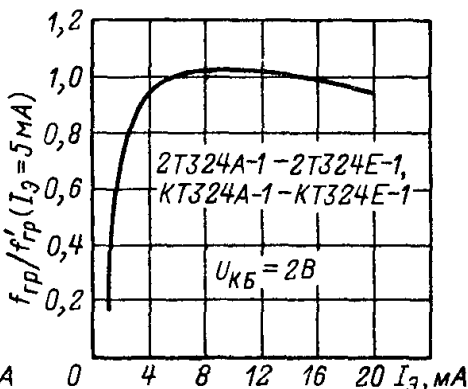
Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база	10 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{ЭБ} \leq 3 \text{ кОм}$	10 В
Постоянное напряжение эмиттер-база	4 В
Постоянный ток коллектора	20 мА
Импульсный ток коллектора при $\tau_n \leq 10 \text{ мкс}$, $Q \geq 10$	50 мА
Постоянная рассеиваемая мощность:	
при $T = 213 \div 328 \text{ К}$	15 мВт
при $T = 358 \text{ К}$	5 мВт
Общее тепловое сопротивление	3 К/мВт
Температура перехода	373 К
Температура окружающей среды	От 213
	до 358 К

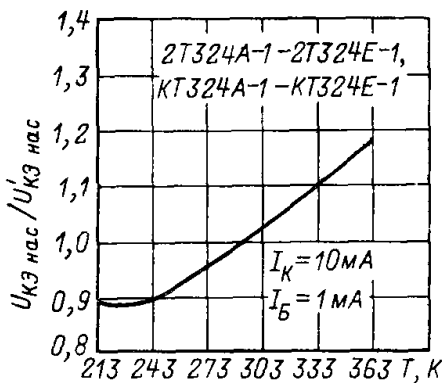
Примечание. При эксплуатации транзисторов в составе микросхем должен быть обеспечен теплоотвод от кристалла с $R_T \leq 3 \text{ К/мВт}$.



Зависимость относительного статического коэффициента передачи тока от тока коллектора.



Зависимость относительной граничной частоты от тока эмиттера.



Зависимость относительного напряжения насыщения коллектор-эмиттер от температуры.

Материал взят из источника: